

СВЕДЕНИЯ

о ведущей организации по диссертации Векшина Михаила Михайловича на тему:
 “Исследование и моделирование поляризационных волноводных элементов микро- и нанофотоники”

<p style="text-align: center;">Полное наименование организации</p>	<p style="text-align: center;">Сокращенное наименование организации</p>	<p style="text-align: center;">Место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»</p>	<p style="text-align: center;">Перечень основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15)</p>
<p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»</p>	<p>ЮРГПУ(НПИ)</p>	<p>346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, 8(8635)25-51-51, kanc@npi-tu.runnet.ru, www.npi-tu.ru</p>	<p>1. Блохин Э.Е., Арустамян Д.А., Алфимова Д.Л. Моделирование гетероструктуры InGaAs/GaAs для фотодетекторов ближнего ИК-диапазона // Вестник Южного научного центра РАН. 2015. Т. 11. №4. С. 16-22.</p> <p>2. Кузнецов В.В., Лозовский В.Н., Попов В.П., Рубцов Э.Р., Середин Б.М. Кинетика термомиграции в системах Si–Al–Ga и Si–Al–Sn // Неорганические материалы, 2018, том 54, № 1, с. 35–39</p> <p>3. Irkha, V., Himmerlich, A., Reiß, S., Krischok, S., Himmerlich, M. Effects of Potassium Adsorption and Potassium-Water Coadsorption on the Chemical and Electronic Properties of n-Type GaN(0001) Surfaces // Journal of Physical Chemistry C. 2018. 122(8). с. 4250-4260.</p> <p>4. Блохин Э.Е. Моделирование QD-InAs/GaAs гетероструктур для фотодетекторов ближнего ИК-диапазона / // Фундаментальные исследования. 2015. № 11-1. С. 39-43.</p> <p>5. Kirpichenkov V. Ya., Kirpichenkova N.V., Lozin O.I., Postnikov A.A. Scattering of Josephson Plasmons on Random</p>

			<p>Quantum Jumpers in a Disordered I-Layer of an S-I- S Junction // Bulletin of the Russian Academy of Science: Physics. 2016. Vol. 80. №5. P. 533 – 535.</p> <p>6. Блохин, Э.Е., Пащенко А.С., Алтынова Н.Е. Исследования гетероструктур InAs/GaAs с потенциальными барьерами AlGaAs и GaAs для фотодетекторов ближнего ИК-диапазона // Известия ЮФУ. Технические науки. 2016. № 2. С. 139-148.</p> <p>7. Knyazev S.Y., Lozovskii V.N., Lozovskii V.S., Seredin B.M. Manifestations of induced instability of phase boundaries during thermomigration // Tech. Phys.Lett. 2016. Vol. 42, No 10. pp. 1045–1048.</p> <p>8. Kirpichenkov V.Ya., Kirpichenkova N.V., Lozin O.I., Postnikov A.A. Low-Temperature Contribution to the Resonant Tunneling Conductance of a Disordered N-I- N Junction // JETP Letters. 2016. V. 104. №7. P. 500 – 503.</p> <p>9. Kirpichenkov V. Ya., Kirpichenkova N.V., Lozin O.I., Pukhlova A.A. Bifurcations of the Creation of Low-Temperature Maxima of the Tunneling Conductance of a "Dirty" N-I-N Junction // JETP Letters. 2017. V. 105. № 9. P. 613 – 616.</p> <p>10. Благин А.В., Благина Л.В., Малибашев А.В., Нефедова Н.А. Тепло- и массоперенос в технологическом процессе градиентной жидкофазной эпитаксии с использованием линейных зон // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2015. № 2. С. 96-100.</p> <p>11. Благин А.В., Благина Л.В., Лозовский С.В., Малибашев А.В., Нефедова Н.А. Влияние анизотропии кристалла на форму движущегося в градиентном поле жидкого включения в технологии синтеза полупроводниковых материалов // Известия высших учебных</p>
--	--	--	---

			<p>заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2015. № 3 (184). С. 90- 94.</p> <p>12. Середин Б.М., Попов В.П., Заиченко А.Н. Формирование дискретных зон на основе алюминия для их термомиграции в кремнии. // Вестник Сев.-Кав. федерального ун-та. 2017. № 1 (58). с.7 – 13.</p> <p>13. Лозовский В.Н., Попов В.П., Середин Б.М. Сравнение диффузионных и эпитаксиальных методов получения радиационно-стойких структур силовых полупроводниковых приборов. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2015. №3. С.57-61.</p> <p>14. Бубликов Е.И., Кулинич В.И., Щербакова Е.Е. Свойства оксидной пленки на поверхности никелевых контактов // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2016. № 9. С. 92-99.</p> <p>15. Bublikov E.I., Shcherbakova E.E., Kulinich V.I. Properties of oxide films on nickel contact surfaces // Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2016. T. 10. № 5. С. 969-976</p>
--	--	--	---

Председатель диссертационного совета Д 212.101.07

В.А. Бабешко

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.101.07



М.В. Зарецкая